

гнучку взаємодію засобів збору експериментальних даних, комп'ютера(ПК). Зв'язок з ПК відбувається за допомогою цифрового інтерфейсу з передачею масиву даних по шині USB комп'ютера. Забезпечення взаємодії модуля вводу-виводу(МВВ) та ПК, організація інформаційних потоків системи, реалізація алгоритмів обробки та відображення отриманих результатів покладене на математичне, інформаційне забезпечення та програмне забезпечення МВВ. [1]

Дана система статистичної діагностики являється мобільною, що дозволяє використовувати її як на етапі виробництва так і в процесі експлуатації. Також система потребує мінімальні апаратурні та вартісні витрати.

1. Сунетчісва С.Р. Апроксимація законів розподілу інформативних параметрів при неруйнівному контролі композиційних матеріалів / С.Ф. Суслов//Східно-Європейський журнал передових технологій «Радіотехнічні інформаційні засоби». 6/11 (60) 2012. — г.Харків.: Технологический центр, 2012—С.45-47.

УДК 539.25; 539.232

## ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ КРИСТАЛІВ

Сичікова Я. О.

Бердянський державний педагогічний університет,  
бул. Шмідта 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна, 71100

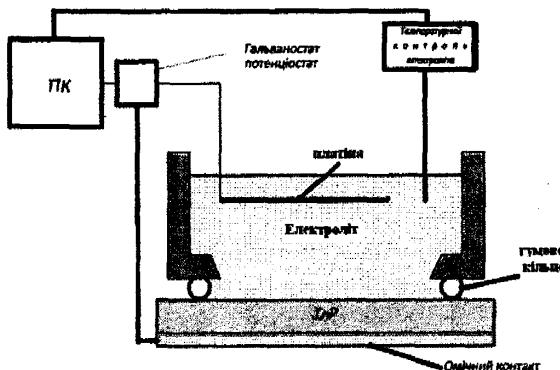
Характерні лінійні розміри функціональних елементів сучасної мікроелектроніки складають одиниці та десятки мікрометрів. Вже перші спроби дослідження й практичного застосування структур з розмірами менш ніж 100 нм показали, що поведінка такихnanoструктур відрізняється від поведінки тіл з великими розмірами. Зменшення лінійних розмірів (хоча би в одному напрямку) кардинально змінює характер квантових електронних станів, що властиві системам зі зниженою розмірністю [1].

Останнім часом значно виріс інтерес до досліджень структур із зниженою розмірністю, що виявляють ряд незвичайних властивостей, якими не володів вихідний напівпровідниковий кристал. Найпростішими можливостями створення такого матеріалу є електрохімічна обробка в спеціальних розчинах, що призводять до формування поруватого простору. Подібна модифікація структурних характеристик поверхні призводить до суттєвих змін фізико-хімічних властивостей вихідного матеріалу.

Порувата поверхня формувалася шляхом анодного електролітичного травлення. Цей метод є найбільш простим, ефективним та дешевим для одержання поруватої поверхні напівпровідників групи  $A^3B^5$  (та інших напівпровідників). Швидкість електродних реакцій залежить не тільки від термодинамічних параметрів, але і від сили струму у відповідності з

рівнянням:  $v = I/nF$ , де  $n$  – число електронів, що беруть участь у даній електродній реакції,  $F$  – число Фарадея.

Схему експериментального пристрою для отримання поруватих плівок на підкладці монокристалічного кристалу методом електрохімічного травлення представлено на рис. 1. Всі електроди зроблені з палладієвого та платинового дроту для того, щоб відповідати умовам механічної надійності та хімічної стійкості. Корпус електрохімічної ванни зроблено з фтороплату-4, що є аналогом тефлону. Вибір цього матеріалу обумовлено тим, що фторопласт-4 відповідає усім вимогам, які були поставлені перед конструкційним матеріалом електрохімічної ванни: механічна надійність, хімічна стійкість, безпека користування, простота обробки та використання, довговічність. Основні характеристики пристрою для травлення наведено в таблиці 1.



**Рисунок 1 - Схема електрохімічної ванни для отримання поруватих сполук методом електрохімічного травлення**

**Таблиця 1 - Технічні характеристики електрохімічної ванни**

Матеріал ванни	фторопласт-4
Матеріал електродів WE,CE,RE,SE	паладій, платина
Можливість використання схем підключення:	
3-х електродна потенціостатична	Підтримується
4-х електродна потенціостатична	Підтримується
2-х електродна батарейна	Підтримується

1. Suchikova Y.A. Morphology of porous n-InP (100) obtained by electrochemical etching in HCl solution / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Functional Materials. – 2010. – Vol.17, №1. – P. 1 – 4.